

2SB755

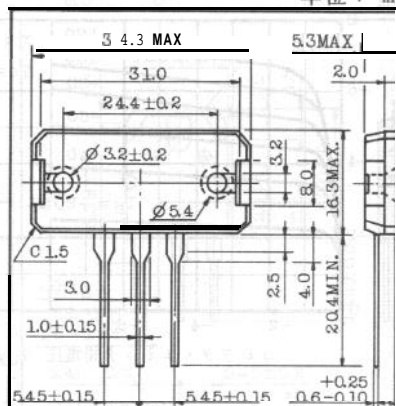
シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

特長

- 高耐圧です。: $V_{CE0} = -150V$ (最小)
- トランジション周波数が高い。: $f_T = 20MHz$ (標準)
- 2SD845 とコンプリメンタリになります。
- 80W ハイファイ オーディオアンプに最適です。

単位: mm



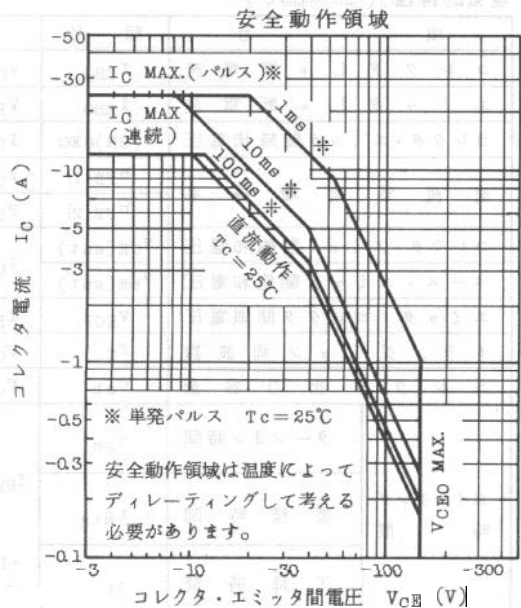
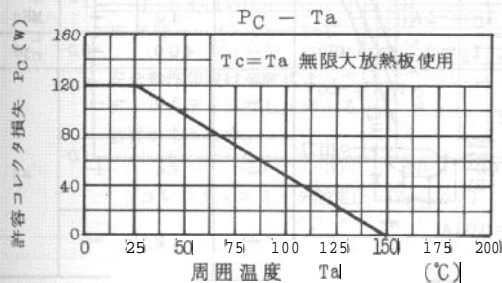
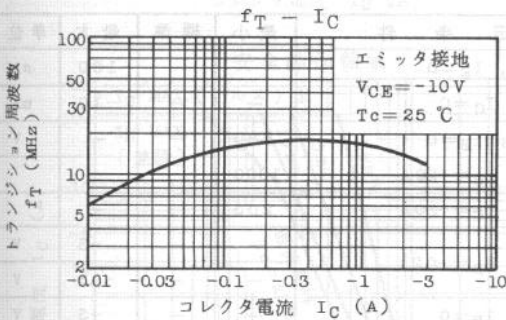
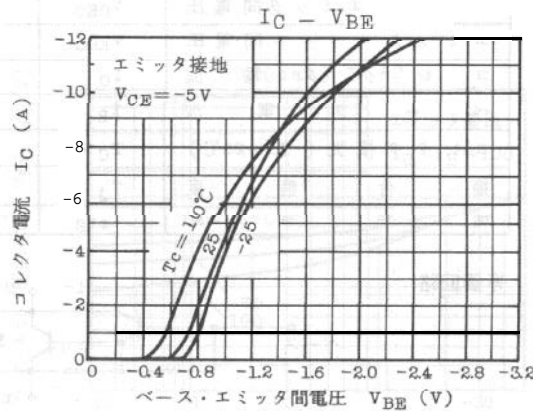
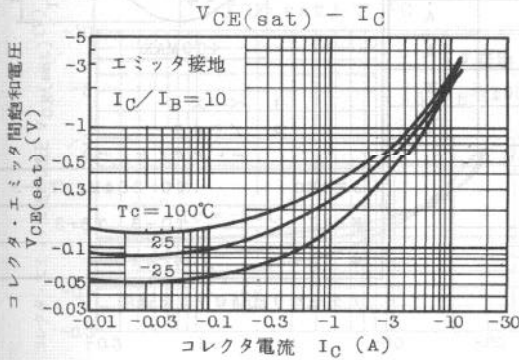
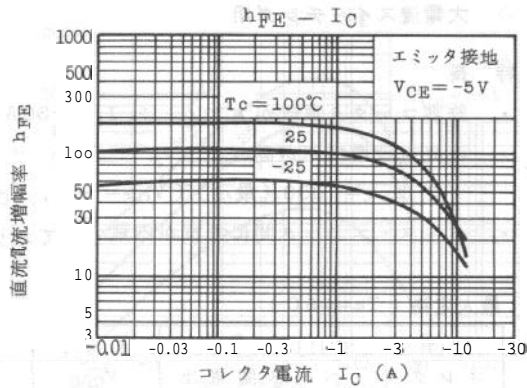
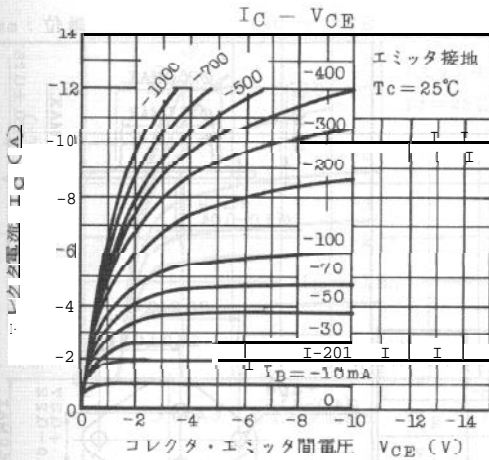
最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-12	A
ベース電流	I_B	-12	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	120	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -150V, I_E = 0$	—	—	-50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-50	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A, I_B = 0$	-150	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE} (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	55	—	160	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5A, I_B = -0.5A$	—	—	-2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -5A$	—	—	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_C = -1A$	—	20	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	450	—	pF

注: h_{FE} 分類 R: 55 ~ 110, Q: 80 ~ 160



This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.